

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPP048N12N3 G</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPP048N12N3 G Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPP048N12N3 G.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23500 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	IPP048N12N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPP048N12N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 230µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12000pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	182nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPP048N12N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP048N12N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP048N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP048N12N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPP048N06LG(048N06L)</b> INFINEON IPP048N06LG(048N06L) INFINEON</p>	 <p><b>IPP048N06L G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A TO-220</p>	 <p><b>IPP048N06L</b> Original IPP048N06L Original</p>	 <p><b>IPP04CN10N G</b> INFINEON IPP04CN10N G INFINEON</p>
 <p><b>IPP04CN10NG</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO220-3</p>	 <p><b>IPP048N04NGXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 70A TO220-3</p>	 <p><b>IPP048N06LG</b> I IPP048N06LG I</p>	 <p><b>IPP048N12N3G</b> INF IPP048N12N3G INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP048N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP048N12N3 G Datenblatt	IPP048N12N3 G-Datenblätter	IPP048N12N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP048N12N3 G
IPP048N12N3 G Electronic	IPP048N12N3 G-Komponenten	IPP048N12N3 G-Verteiler	IPP048N12N3 G-Bild	IPP048N12N3 G-Teil
IPP048N12N3 G Preis	IPP048N12N3 G Hersteller	IPP048N12N3 G Bild	IPP048N12N3 G Aktie	IPP048N12N3 G Inventar
IPP048N12N3 G Neu	IPP048N12N3 G Original	IPP048N12N3 G garantiert	IPP048N12N3 G RFQ	IPP048N12N3 G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited